

シリコンPNP三重拡散メサ形トランジスタ
SILICON PNP TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR

2SA483

○電力増幅用 ○垂直偏向出力用

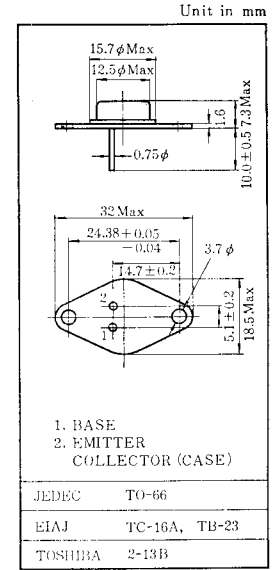
○ Power Amplifier Applications

○ Vertical Output Applications

- 耐圧が高い: $V_{CE0} = -150V$
- 2SC783 と組合せて高出力 Hi-Fi アンプ (100W, 200Wクラス) の励振段に適しています。
- Suitable for the Driver Amplifier of 100~200W High Power Hi-Fi System with 2SC783 as a Complement.

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-150	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-150	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-1.5	A
エミッタ電流	I_E	1.5	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_C	20	W
接合温度	T_J	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-65~150	$^\circ C$



アクセサリはAC74を適用
MOUNTING KIT NO. AC74

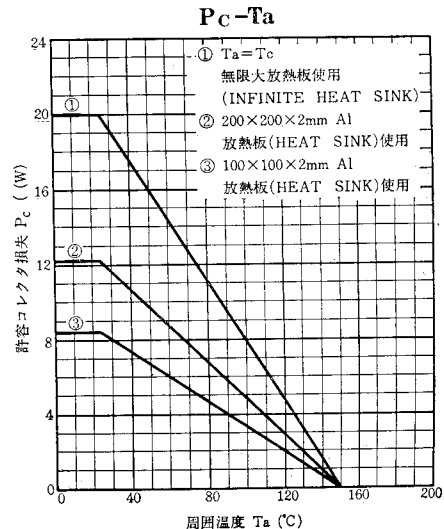
電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -150V, I_E = 0$	—	—	-100	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	—	—	-100	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -10mA, I_B = 0$	-150	—	—	V
コレクタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C = -0.5mA, I_B = 0$	-150	—	—	V
直流電流増幅率 (Note)	h_{FE}	$V_{CE} = -10V, I_C = -0.1A$	30	—	240	
コレクタ・エミッタ間サステイニング電圧	$V_{CEO(SUS)}$	$I_C = -0.2V$	-150	—	—	V
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -0.5A, I_B = -0.05A$	—	—	-1.8	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -10V, I_C = -0.5A$	—	—	-1.8	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -10V, I_C = -0.1A$	—	10	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, f = 1MHz$	—	50	—	pF

Note; h_{FE} により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of h_{FE} , the 2SA483 is classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SA483-R	30	80
2SA483-O	70	140
2SA483-Y	120	240



This datasheet has been downloaded from:

www.DatasheetCatalog.com

Datasheets for electronic components.